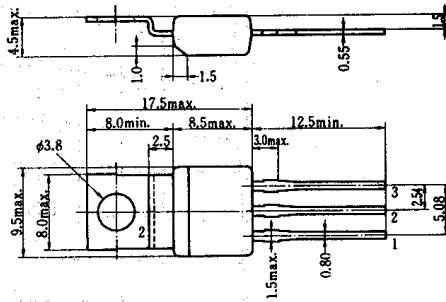


シリコン NPN 三重拡散形
高周波高電圧増幅用
TV 映像出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH FREQUENCY HIGH VOLTAGE AMPLIFIER
TV VIDEO OUTPUT



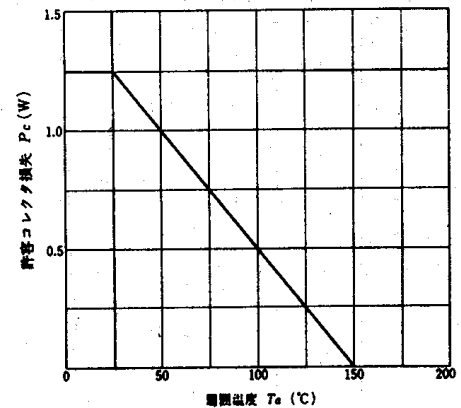
1.ベース: Base
2.コレクタ: Collector
3.エミッタ: Emitter
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-202AA MOD.)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SC1514	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	300	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	300	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_c	100	mA
許容コレクタ損失	P_c	1.25	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45 ~ +150	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_c=10\mu\text{A}, I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_c=1.0\text{mA}, R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=0.1\text{mA}, I_c=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CE0}	$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_c=20\text{mA}, I_B=2.0\text{mA}$	—	—	1.5	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=20\text{V}, I_c=20\text{mA}$	30	—	200	
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=20\text{V}, I_c=20\text{mA}$	50	80	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	—	4.0	pF